

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 03038069
PUBLICATION DATE : 19-02-91

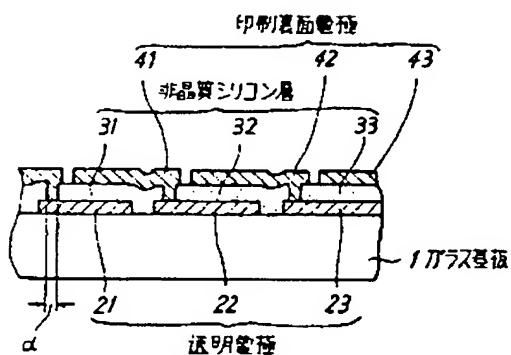
APPLICATION DATE : 04-07-89
APPLICATION NUMBER : 01172743

APPLICANT : FUJI ELECTRIC CO LTD;

INVENTOR : SATO KOKI;

INT.CL. : H01L 31/04

TITLE : THIN FILM SOLAR CELL



ABSTRACT : PURPOSE: To enable the title thin film solar cell in excellent characteristics to be manufactured at low cost by a method wherein the rear surface electrodes are formed by printing and baking a conductive paste containing almost spherical powder bodies in spherical diameter not exceeding 1.2µm as a conductive material using phenol resin as a binder.

CONSTITUTION: Transparent electrodes 21, 22... comprising transparent conductive film, photoelectromotive force layers 31, 32... and printed electrodes 41, 42... as the second electrodes are successively formed in strip shape on an insulating translucent substrate 1 such as glass, etc. The printed electrodes 41, 42 are formed by printing and baking a conductive paste containing almost spherical molybdenum powder bodies in spherical diameter not exceeding 1.2µm as a conductive material using phenol resin as a binder. Through these procedures, the title thin film solar cell having sufficient characteristics can be manufactured at low cost.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

平3-38069

⑬ Int. Cl.⁵
H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)2月19日

7522-5F H 01 L 31/04
7522-5F

M
E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 薄膜太陽電池

⑯ 特願 平1-172743

⑰ 出願 平1(1989)7月4日

⑱ 発明者 佐藤 広喜 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内

⑲ 出願人 富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

⑳ 代理人 弁理士 山口 嶽

明細書

1. 発明の名称 薄膜太陽電池

2. 特許請求の範囲

1) 半導体薄膜からなる光電変換部を有し、絶縁透光性基板を通して光電変換部に光が入射して生ずる熱起電力を、基板側の透明電極と反基板側の印刷電極から取出すものにおいて、印刷電極が直径1.2mm以下のはぼ球形のモリブデン粉体を導電材料として含み、フェノール樹脂をバインダとした導電ペーストの印刷、焼成によって形成されたことを特徴とする薄膜太陽電池。

3. 発明の詳細な説明

(商業上の利用分野)

本発明は、非晶質シリコン、II-VI族あるいはカルコバイライト系化合物半導体の薄膜からなる光電変換部を有し、絶縁透光性基板を通して光電変換部に光が入射して生ずる熱起電力を、基板側の透明電極と反基板側の印刷電極から取出す薄膜太陽電池に関する。

(従来の技術)

薄膜太陽電池において、光の入射側に設けられる透明電極に対向する裏面電極としては金属の蒸着やスパッタリングなどによって被着された金属電極が用いられていた。しかし、薄膜太陽電池の低成本化のため裏面電極をエポキシ系樹脂をバインダとしたカーボンペーストまたは銀ペーストを用いた印刷電極に代えることが行われるようになった。第1図はそのような薄膜太陽電池を示し、ガラスなどの絶縁透光性基板1の上に、第一電極としてSnO_xなどの透明導電膜からなる透明電極21, 22, 23…、光起電力層としてP-I-N接合構造をもつ非晶質シリコン層31, 32, 33…、第二電極として印刷電極41, 42, 43…を順次組田状に形成し、この段公知のやり方でパターンをすらすことにより単位セルが直列接続となるように作製される。このような太陽電池は、裏面電極をスクリーンマスクを用いて印刷すれば第二電極のパターンが形成されるので、バターニングアロセスが省略できるだけでなく、スループットの大幅な向上も実現される。

(発明が解決しようとする課題)

裏面電極を印刷法で形成した薄膜太陽電池は、印刷電極と半導体層の間の接触抵抗が大きく、直列抵抗成分が大きい。そのため、電車用などの低照度、低電流下で使用する用途ではあまり問題とはならないが、太陽光下で用いる電力用途では、この抵抗分が光电変換素子の出力特性に大きな影響を及ぼす。すなわち、入射光量の増加に伴いフィルファクタが低下し、変換効率が著しく制限される。

本発明の課題は、上記の欠点を除去し、裏面電極として印刷電極を用いても実用上問題とならないような良好な接触を半導体層との間に形成し、低成本の薄膜太陽電池を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記の課題の解決のために、本発明は、半導体薄膜からなる光电変換部を有し、絶縁導電性基体を通して光电変換部に光が入射して生ずる熱起電力を、基板側の透明電極と反基板側の印刷電極から取出す薄膜光电変換素子において、印刷電極が

一層アモルファスシリコン (a-Si:H) 層、約 300 Å の厚さの n 形 a-Si:H 層をグロー放電分解法で積層した非晶質シリコン層 3 を形成した。裏面電極 4 は Ni, Ni + Ag, Mo, W, C の粉体を導電材料とし、それらとバインダとしてのフェノール樹脂を混合したものをベースト材料として所定のパターンに塗布し、150~170 °C で約 60 分間焼成を行い、擬似太陽光 (AM1.0, 100mW/cm²) 下での発電特性を調べた。第 3 図はその結果を示すもので、裏面電極 4 に各ベースト材を用いた第 2 図の構造の太陽電池で得られた特性の開放電圧 V_{oc}、短絡電流密度 J_{sc}、フィルファクタ F_F、変換効率 η および直列抵抗 R_s を示す。比較のために真空蒸着で形成した Mo 電極を裏面電極とした太陽電池の特性も同時に示してある。

第 3 図から、Mo 粉体を導電材料としても、他の粉体を導電材料としたものにくらべて F_F、η が高く、R_s は約 1 衍以上小さくなっている。蒸着 Mo 電極の太陽電池と同程度の性能を示すことがわかる。また、バインダとしてフェノール樹脂

直徑が 1.2 mm 以下のほぼ球形のモリブデン粉体を導電材料として含み、フェノール樹脂をバインダとした導電ベーストの印刷、焼成によって形成されたものとする。

(作用)

導電材料として直徑 1.2 mm 以下のほぼ球形のモリブデン粉体を含み、フェノール樹脂をバインダとして用いた導電ベーストを印刷、焼成した裏面電極は半導体薄膜との接触抵抗が蒸着あるいはスパッタリングで形成されたアルミニウム電極とほぼ同程度となり、その結果、太陽光下のような発電電流の大きな条件においても著しいフィルファクタの低下は見られず、実用太陽電池として必要な 7% 以上の変換効率が達成される。

(実施例)

第 2 図の構造の太陽電池を次のようにして作製した。ガラス基板 1 上に 4500 Å の厚さの SiO₂ からなる透明電極 2 を 1 µm の大きさに形成し、その上に約 200 Å の厚さの p 形アモルファスシリコンカーボン (a-SiC:H) 層、約 5000 Å の厚さのアンド

の代わりにエポキシ樹脂を用いた導電ベーストにより裏面電極 4 を形成すると、F_F は 0.4 以下となり、太陽光下では十分な特性が得られないことが分かった。

第 3 図に示した特性を得た Mo 粉体導電ベーストの組成は金属性粉体とフェノール樹脂の重量比が 4 対 1 であり、Mo 粉体の形状はほぼ球状でその直徑は 0.6 mm であった。Mo 粉体の球径を換えたところ第 4 図の結果が得られた。すなわち、Mo 粉体は微細なほど望ましいが、実用太陽電池として必要とされる 7% 以上の η を得るには 1.2 mm 以下の球径の Mo 粉体を用いなければならない。

また、Mo 粉体とフェノール樹脂からなる導電ベーストに界面活性剤であるシランカップリング剤を混合したものを用いると、特性はさらに改善されることが示された。すなわち、シランカップリング剤を重量比で約 2% 混合したベーストを用いた場合には、F_F は 0.62 から 0.65 へ、η は 7.5% から 8% に向上し、Mo 電極に対してまったく退色のない特性が得られた。

本発明に基づく (Mo+フェノール樹脂) の導電ベーストを用いて第1図に示した直列接続型の太陽電池を試作したところ、印刷裏面電極41,42…の隣接する単位セルの第一電極22,23…との接觸幅dを0.2 mmとしても、蒸着裏面電極を用いて試作した従来構造のものと同等の特性を示し、実用的な薄膜太陽電池に本発明を適用した場合も十分な性能が得られることが示される。

(発明の効果)

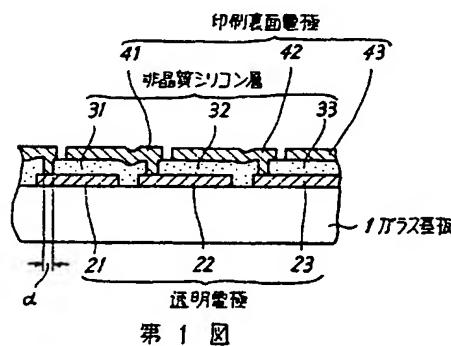
本発明によれば、導電材料としてはほぼ球形でその球径が1.2 mm以下の粉体を用い、バインダとしてフェノール樹脂を用いた導電ベーストの印刷、焼成により裏面電極を形成することにより、蒸着あるいはスパッタにより形成された金属裏面電極を有する薄膜太陽電池に比して退色のない発電特性が得られた。これにより、工程が省略できるだけでなく、電極形成に真空装置を用いる必要がないのでスループットが大幅に向上し、特性良好な薄膜太陽電池を低コストで製造することが可能になった。

4. 図面の簡単な説明

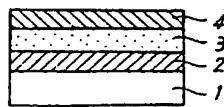
第1図は本発明の実施される印刷裏面電極を備えた薄膜太陽電池の断面図、第2図は本発明の効果を実証するために試作した薄膜太陽電池の断面図、第3図は本発明の実施例の印刷電極のための導電ベーストに種々の導電材料を用いた場合および蒸着裏面電極を形成した場合の薄膜太陽電池の特性比較グラフ、第4図は導電材料のMo粉体の球径と薄膜太陽電池の変換効率との関係図である。

1：ガラス基板、21,22,23：透明電極、31,32,33：非晶質シリコン層、41,42,43：印刷裏面電極。

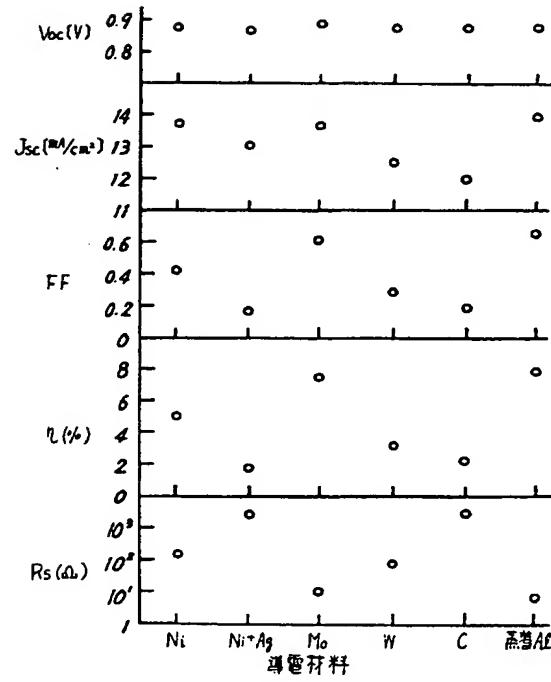
代理人弁理士 山口 勝



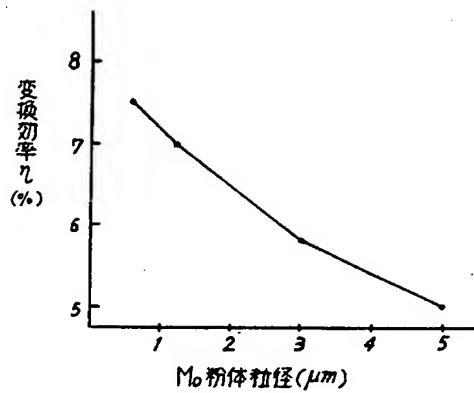
第1図



第2図



第3図



第4図